（２）特定半導体生産施設における生産の内容

（イ）施設で生産を行う半導体に関する内容

| 種類（注４） | 性能に関する説明（注５）（注６） |
|---|---|
| | |

（注４）演算を行う半導体（トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートル以下）、記憶を行う半導体（一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の面積が千三百七十平方ナノメートル以下）、記憶を行う半導体（積層された一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の層の数が百六十以上）のいずれかから選択し記載すること。

（注５）生産予定の製品が政令で定める要件を満たす旨を記載すること。また、生産予定の製品が記載する性能を満たすことを示す書類を認定計画申請時及び初回の製品生産時に提出すること。

（注６）生産予定の製品が「演算を行う半導体（トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートル以下）」の場合は、ゲート絶縁膜に比誘電率が７を超える材料を用いるための装置を使用して生産することを示す書類及び当該生産に係る特定半導体生産施設整備等計画を申請する事業者のうち１以上の事業者がＦｉｎＦＥＴ構造の演算を行う半導体を生産できると認められる技術水準を有することを示す書類を提出すること。
生産予定の製品が「記憶を行う半導体（一ビットの情報の記憶に必要な電子回路の面積が千三百七十平方ナノメートル以下）」の場合は、当該生産に係る特定半導体生産施設整備等計画を申請する事業者のうち１以上の事業者が極端紫外線を用いて露光できると認められる技術水準を有することを示す書類を提出すること。

（ロ）特定半導体生産施設整備等計画の下での事業実施期間

| | 初回出荷 | 継続生産 |
|---|---|---|
| 特定半導体生産施設における生産 | 年　月 | 年　月～　年　月 |

（ハ）製品の納入先に関する説明

| |
|---|
| |

（ニ）コア技術等に関する説明（注７）

| |
|---|
| |

（注７）本計画の認定の対象とする取組における生産に有用かつ中核的な技術（公然と知られていないものに限る）を「コア技術」と定義し、コア技術及びコア技術の実現に直接寄与する公然と知られていない技術を「コア技術等」と定義する。

（３）指針適合性の確保

| 項目 | | 確保措置の内容（注８） |
|---|---|---|
| 整備適合性 | 必要な設備の整備 | □　特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針（以下「指針」という。）第四　一　２に掲げる設備の整備を含んでいる。 |
| | 指針に適合する設備の整備 | □　整備する設備は指針第四　一　３に掲げるいずれかに含まれる。 |
| | 指針に適合する施設の整備 | □　整備する施設は指針第四　一　４に掲げるいずれかに含まれる。 |
| 安全性・信頼性 | 所有関係及びガバナンスの透明性の確保 | |
| | 過去三年間の実績を含めた、国際的に受け入れられた基準の遵守（注９） | □　過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準に反していない。 |
| | 外国の法的環境等による特定半導体生産施設整備等の適切性への影響 | |
| | 生産を行う特定半導体のサイバーセキュリティの確保に関する対策及び生産施設におけるサイバーセキュリティの確保に関する対策 | |
| | コア技術等の流出防止に関する取組 | □　指針第四　一　１３に掲げる措置を実施する。 |
| 供給安定性等 | サプライチェーンを含む必要な生産能力確保に関する計画の整備 | □　必要な計画を整備している。 |
| | 事業継続計画の策定 | |
| | 特定半導体の生産に係る国内関係法令の遵守 | |
| | 人材確保に関する取組 | |
| | その他国内の特定半導体の安定供給に資する取組 | |

（注８）必要に応じて各項目を証明する書類を提出すること。

（注９）過去三年間の実績を含め、国際的に受け入れられた基準に反していない場合は、□にレ印を付けること。